

# TBJ

Son indicados para circuitos de todo tipo, amplificación en general, y en particular los de ruido ultra bajo son la opción idónea para fuentes de baja impedancia, como cápsulas MC, etc.

Transistor	tipo	comp.	car.	caps.	volt.	corriente	potencia
2SA1083	PNP	2SC2545	ULN	TO-92	60	100mA	400mW
2SA1084	PNP	2SC2546	ULN	TO-92	90	100mA	400mW
2SA1085	PNP	2SC2547	ULN	TO-92	120	100mA	400mW
2SC2545	NPN	2SA1083	ULN	TO-92	60	100mA	400mW
2SC2546	NPN	2SA1084	ULN	TO-92	90	100mA	400mW
2SC2547	NPN	2SA1085	ULN	TO-92	120	100mA	400mW
2SA970	PNP	2SC2240	ULN	TO-92	120	100mA	300mW
2SC2240	NPN	2SA970	ULN	TO-92	120	100mA	300mW
2SC3112	NPN		SB-LN	TO-92	50	150mA	400mW
2SA1048L	PNP	2SC2458L	LN	TO-92	50	150mA	200mW
2SC2458L	NPN	2SA1048L	LN	TO-92	50	150mA	200mW
2SA1015L	PNP	2SC1815L	LN	TO-92	50	150mA	400mW
2SC1815L	NPN	2SA1015L	LN	TO-92	50	150mA	400mW
BC546	NPN	BC556	LN	TO-92	60	100mA	625mW
BC547	NPN	BC557	LN	TO-92	45	100mA	625mW
BC548	NPN	BC558	LN	TO-92	30	100mA	625mW
BC549	NPN	BC559	LN	TO-92	30	100mA	500mW
BC550	NPN	BC560	LN	TO-92	50	200mA	500mW
BC556	PNP	BC546	LN	TO-92	60	100mA	625mW
BC557	PNP	BC547	LN	TO-92	45	100mA	625mW
BC558	PNP	BC548	LN	TO-92	30	100mA	625mW
BC559	PNP	BC549	LN	TO-92	30	100mA	500mW
BC560	PNP	BC550	LN	TO-92	50	200mA	500mW
BC635	NPN	BC636		TO-92	45	1000mA	830mW
BC637	NPN	BC638		TO-92	60	1000mA	830mW
BC639	NPN	BC640		TO-92	80	1000mA	830mW
BC636	PNP	BC635		TO-92	45	1000mA	830mW
BC638	PNP	BC637		TO-92	60	1000mA	830mW
BC640	PNP	BC639		TO-92	80	1000mA	830mW
2SA1312	PNP	2SC3324	LN	SOT-23	120	100mA	150mW
2SC3324	NPN	2SA1312	LN	SOT-23	120	100mA	150mW
BC850	NPN	BC860	LN	SOT-23	50	100mA	225mW
BC860	PNP	BC850	LN	SOT-23	60	100mA	225mW
BC847BS	NPN	BC857BS	LN-D	SOT-363	45	100mA	225mW
BC857BS	PNP	BC847BS	LN-D	SOT-363	45	100mA	225mW
BC847BPN		DUAL N&P	LN-D	SOT-363	45	100mA	225mW
BCV61	NPN	BCV62	CM	SOT-143	30	100mA	300mW
BCV62	PNP	BCV61	CM	SOT-143	30	100mA	300mW
LM394	NPN		U-D	DIP-8	35	20mA	500mW
MAT02	NPN	MAT03	U-D	TO-78	40	20mA	500mW
MAT03	PNP	MAT02	U-D	TO-78	35	20mA	500mW
SSM-2210	NPN	SSM-2220	U-D	DIP-8	40	20mA	500mW
SSM-2220	PNP	SSM-2210	U-D	DIP-8	35	20mA	500mW

SB	Super-beta (alta Hfe)
ULN	Ultra bajo ruido.
LN	Bajo ruido.
LN-D	Transistor dual, bajo ruido.
U-D	Transistor dual, ultra bajo ruido.
CM	Espejo de corriente.

#### TBJ media potencia

Transistores con una potencia nominal entre 1 y 20W, lo que da unas características intermedias entre un buen manejo de la señal y el aguante de los grandes. Su uso está asignado a drivers de transistores de alta potencia, transistores de compensación térmica, etc.

Transistor	tipo	comp.	caps.	volt.	corriente	potencia
2SC3419	NPN	2SA1356	TO-126	40	800	5
2SA1356	PNP	2SC3419	TO-126	40	800	5
2SC3420	NPN	2SA1357	TO-126	40	5000	10
2SA1357	PNP	2SC3420	TO-126	40	5000	10
2SC3421	NPN	2SA1358	TO-126	120	1000	10
2SA1358	PNP	2SC3421	TO-126	120	1000	10
2SC3422	NPN	2SA1359	TO-126	40	3000	10
2SA1359	PNP	2SC3422	TO-126	40	3000	10
2SC3423	NPN	2SA1360	TO-126	150	50	5
2SA1360	PNP	2SC3423	TO-126	150	50	5
2SC3621	NPN	2SA1408	TO-126	150	1500	10
2SA1408	PNP	2SC3621	TO-126	150	1500	10
2SC3963	NPN		TO-126	160	200	1.5
2SC4793	NPN	2SA1837	TO-220	230	1000	20
2SA1837	PNP	2SC4793	TO-220	230	1000	20
2SC4883	NPN	2SA1859	TO-220	180	2000	20
2SA1859	PNP	2SC4883	TO-220	180	2000	20
BD139	NPN	BD140	TO-126	80	1500	12.5
BD140	PNP	BD139	TO-126	80	1500	12.5
BF459	NPN		TO-126	300	300	12.5
BF471	NPN	BF472	TO-126	300	100	2
BF472	PNP	BF471	TO-126	300	100	2
MJE340	NPN	MJE350	TO-126	300	500	20
MJE350	PNP	MJE340	TO-126	300	500	20
2SC5460	NPN		TO-126	800	50	10

## TBJ de potencia

Potencias mayores de 30W. Se emplean en etapas de salida de amplificadores y reguladores de media y alta potencia, etc.

Transistor	tipo	comp.	caps.	volt.	corriente	potencia
2SA1693	PNP	2SC4466	TO-3P	80	6	60
2SC4466	NPN	2SA1693	TO-3P	80	6	60
2SA1695	PNP	2SC4468	TO-3P	140	10	100
2SC4468	NPN	2SA1695	TO-3P	140	10	100
2N3055	PNP	MJ2955	TO-3	60	15	115
MJ2955	NPN	2N3055	TO-3	60	15	115
2SC3263	NPN	2SA1294	TO-3P	230	15	130
2SA1294	PNP	2SC3263	TO-3P	230	15	130
2SC5242	NPN	2SA1962	TO-3P	230	15	130
2SA1962	PNP	2SC5242	TO-3P	230	15	130
MJ15015	NPN	MJ15016	TO-3	120	15	140
MJ15016	PNP	MJ15015	TO-3	120	15	140
2SA1943	PNP	2SC5200	TO-247	230	15	150
2SC5200	NPN	2SA1943	TO-247	230	15	150
2SC3264	NPN	2SA1295	MT-200	230	17	200
2SA1295	PNP	2SC3264	MT-200	230	17	200
2SC3858	NPN	2SA1494	MT-200	200	17	200
2SA1494	PNP	2SC3858	MT-200	200	17	200
2SA1216	PNP	2SC2922	MT-200	180	17	200
2SC2922	NPN	2SA1216	MT-200	180	17	200
MJ15001	NPN	MJ15002	TO-3	140	15	200
MJ15002	PNP	MJ15001	TO-3	140	15	200
MJ15003	NPN	MJ15004	TO-3	140	20	250
MJ15004	PNP	MJ15003	TO-3	140	20	250
MJ15022	NPN	MJ15023	TO-3	200	16	250
MJ15023	PNP	MJ15022	TO-3	200	16	250
MJ15024	NPN	MJ15025	TO-3	250	16	250
MJ15025	PNP	MJ15024	TO-3	250	16	250

## J-FET

Los transistores J-FET son muy recomendados para las etapas de entrada, dada su alta impedancia. También son muy recomendables ya que su ruido de corriente es muy bajo. Sirven también como fuente de corriente que se polariza automáticamente.

Transistor	tipo	comp.	car.	caps.	volt.	Idss	potencia
2N3819	N	2N3820	LN	TO-92	25	2-20	350mW
2N3820	P	2N3819	LN	TO-92	20	0.3-15	350mW
2N3958	N		LN-D	TO-71	50	0.5-5	500mW
2N5196/7/8/9	N		LN-D	TO-71	50	0.7-7	500mW
2N5460/1/2	P			TO-92	40	1-16	625mW
MMBF5460/1	P			SOT-23	40	1-9	350mW
BF245	N			TO-92	30	2-25	625mW
2N5911/2	N		LN-D	TO-71	35	7-40	350mW
2SK246	N	2SJ103		TO-92	50	1.2-14	300mW
2SK30ATM	N		LN	TO-92	50	0.3-6.5	100mW
2SK2145	N		ULN-D	2-2L1-B	50	1.2-14	300mW
2SK3320	N		ULN-D	2-2L1-B	50	1.2-14	200mW
2SK389	N	2SJ109	ULN-D	2-10M1A	50	2.6-20	200mW
2SK170	N	2SJ74	ULN	TO-92	40	2.6-20	400mW
2SK208	N	2SJ106	LN	SOT-23	50	1.2-14	150mW
2SJ74	P	2SK170	ULN	TO-92	40	2.6-20	400mW
2SJ103	P	2SK246		TO-92	50	1.2-14	300mW
2SJ109	P	2SK389	ULN-D	2-10M1A	30	2.6-20	200mW
2SJ106	P	2SK208	LN	SOT-23	50	1.2-14	150mW
J304/5	N		LN	TO-92	30	1-15	350mW
PMBFJ308/9/10	N		LN	SOT-23	25	12-60	250mW
SST/U401/4/6	N		LN-D	TO-71	40	0.5-10	600mW

ULN      Ultra bajo ruido.  
LN        Bajo ruido.  
D        Transistor dual

## MOS-FET de potencia

Los transistores mosfet de potencia son exclusivos para las etapas de salida, o como drivers de etapas de salida con varios dispositivos en paralelo.

La especialización para conmutación y aplicaciones muy exigentes en cuanto a potencia y corriente máxima ha dado como resultado modelos de excepcionales prestaciones pero que sólo existen en tipo N.

Son especialmente indicados para etapas de salida clase A, por su mayor linealidad a altas corrientes, ausencia de ruptura secundaria y que no requieren corriente para controlarlos.

Transistor	tipo	comp.	caps.	volt.	Idss	potencia
2SK1530	N	2SJ201	2-21F1B	200	15	150
2SJ201	P	2SK1530	2-21F1B	200	15	150
2SK1529	N	2SJ200	16C1B	180	10	120
2SJ200	P	2SK1529	16C1B	180	10	120
2SK1170	N		TO-3P	500	20	120
2SK413	N	2SJ118	TO-3P	140	8	100
2SJ118	P	2SK413	TO-3P	140	8	100
2SK414	N	2SJ119	TO-3P	160	8	100
2SJ119	P	2SK414	TO-3P	160	8	100
2SK1058	N	2SJ1621	TO-3P	160	7	100
2SJ162	P	2SK1058	TO-3P	160	7	100
IRF540	N	IRF9540	TO-220	100	28	150
IRF9540	P	IRF540	TO-220	100	23	150
IRF640	N	IRF9640	TO-220	200	18	125
IRF9640	P	IRF640	TO-220	200	11	125
IRF140	N	IRF9140	TO-3	100	28	125
IRF9140	P	IRF140	TO-3	100	18	125
IRF150	N		TO-3	100	38	150
IRFP150	N		TO-247	100	41	230
IRFP240	N	IRFP9240	TO-247	200	20	150
IRFP9240	P	IRFP240	TO-247	200	12	150
IRFP250	N		TO-247	200	33	180
IRFP254	N		TO-247	250	23	190
IRFP260N	N		TO-247	200	50	300
IRFP264	N		TO-247	250	38	280
IRFP22N50A	N		TO-247	500	22	277
BUZ90	N		TO-220	600	4,5	75
BUZ91	N		TO-220	600	8	150
BUZ900P	N	BUZ905P	TO-247	160	8	125
BUZ905P	P	BUZ900P	TO-247	160	8	125
BUZ900DP	N	BUZ905DP	TO-3P	160	16	250
BUZ905DP	P	BUZ900DP	TO-3P	160	16	250
BUZ901P	N	BUZ906P	TO-247	200	8	125
BUZ906P	P	BUZ901P	TO-247	200	8	125
BUZ901DP	N	BUZ906DP	TO-3P	200	16	250
BUZ906DP	P	BUZ901DP	TO-3P	200	16	250